文章编号:1000-7032(2023)10-1797-06

锌铊共掺碘化钠晶体的生长及闪烁性能

田东升1.2,张 斌3,尹祖荣1,力茂林1,

徐悟生3*,张镇玺1,贾永超4*,徐朝鹏1*

(1. 燕山大学信息科学与工程学院,河北省特种光纤与光纤传感实验室,河北秦皇岛 066004;2. 燕山大学理学院河北省微结构材料物理重点实验室,河北秦皇岛 066004;

3. 秦皇岛本征晶体科技有限公司,河北秦皇岛 066000; 4. 燕山大学环境与化学工程学院,河北秦皇岛 066004)

摘要:采用坩埚下降法生长了NaI:Zn(0,0.05%,0.08%,0.4%),Tl(0.18%)晶体。对晶体样品进行了X射线粉末衍射、电感耦合等离子体发射光谱以及紫外可见近红外透射光谱测试。结果表明,生长的晶体具有单一的物相,Zn和Tl离子掺杂并没有改变NaI的晶体结构;随着Zn掺杂浓度的增加,晶体内的Zn²⁺离子浓度增加、Tl*离子浓度下降;晶体透过率随Zn掺杂浓度的增加呈现先增大后减小的趋势,Zn掺杂浓度为0.08%时,样品的透过率最高,且所有样品在350~700 nm波段的透过率均高于70%。经过切割、打磨、抛光、封装等工序将NaI:Zn,Tl晶体封装成辐射探测元件。闪烁性能测试结果表明,在¹³⁷Cs放射源激发下,Zn掺量为0.05%、0.08%时的NaI:Zn,Tl晶体的能量分辨率<6.80%,光输出相对于NaI:Tl晶体增加6%~10%,这有利于NaI晶体在高能粒子探测领域的进一步应用。

关 键 词: 碘化钠晶体; Zn掺杂; 坩埚下降法; 晶体生长; 透过率; 能量分辨率; 相对光输出 **中图分类号:** 0482. 31 **文献标识码:** A **DOI**: 10. 37188/CJL. 20230171

Growth and Scintillation Properties of Zinc and Thallium-codoped Sodium Iodide Crystals

TIAN Dongsheng^{1,2}, ZHANG Bin³, YIN Zurong¹, LI Maolin¹, XU Wusheng^{3*},

ZHANG Zhenxi¹, JIA Yongchao^{4*}, XU Zhaopeng^{1*}

 The Key Laboratory for Special Fiber and Fiber Sensor of Hebei Province, School of Information Science and Engineering, Yanshan University, Qinhuangdao 066004, China;

2. The Key Laboratory for Microstructural Material Physics of Hebei Province, School of Science, Yanshan University,

Qinhuangdao 066004, China;

3. Qinhuangdao Intrinsic Crystal Technology Co. , Ltd. , Qinhuangdao 066000, China;

4. School of Environmental and Chemical Engineering, Yanshan University, Qinhuangdao 066004, China)

* Corresponding Authors, E-mail: wusheng. xu@icc-crystal. com; yongchao. jia@ysu. edu. cn; xuzhaopeng1@163. com

Abstract: NaI: Zn(0, 0.05%, 0.08%, 0.4%), Tl(0.18%) crystals were grown using Bridgman method respectively. The crystal samples were tested by X-ray powder diffraction, inductively coupled plasma emission spectra, and ultraviolet-visible near-infrared transmission spectra. The results show that the grown crystals have a single phase, and the crystal structure of NaI does not change with Zn and Tl ions doping. As the doping concentration of Zn increases, the concentration of Zn²⁺ ions in the crystal increases, while the concentration of Tl^{*} ions decreases. The transmittance shows a trend of firstly increasing and then decreasing with the increase of Zn doping concentration.

收稿日期: 2023-07-25;修订日期: 2023-08-10

基金项目:中央引导地方科技发展资金(206Z1101G);秦皇岛市科学技术研究与发展计划(202003B008);河北省创新能力提升项目(22567605H);河北省自然科学基金(E2021203126,C20220329);燕山大学基础创新科研培育项目(2021LGQN033) Supported by The Central Guidance on Local Science and Technology Development Fund of Hebei Province (206Z1101G); Science and Technology Development Program of Qinhuangdao City (202003B008); Innovation Capability Improvement Project of Hebei province (22567605H); Natural Science Foundation of Hebei Province (E2021203126,C20220329); Cultivation Project for Basic Research and Innovation of Yanshan University(2021LGQN033)

发 光 学 报

When the doping concentration of Zn is 0.08%, the transmittance of the sample is the highest. The transmittance of all the NaI: Zn, Tl crystals is higher than 70% in the 350–700 nm wavelength range. After cutting, polishing, and packaging processes, NaI: Zn, Tl crystals were enveloped into radiation detection components. The scintillation performance test results showed that under the excitation of a ¹³⁷Cs radiation source, the energy resolution of NaI: Zn, Tl crystals with Zn doping of 0.05% and 0.08% were less than 6.80%, and the light output increased 6%–10% compared with that of NaI: Tl crystal. This is conducive to the further application of NaI crystals in the field of high-energy particle detection.

Key words: sodium iodide crystal; Zn²⁺ doped; Bridgman method; crystal growth; transmittance; energy resolution; relative light output

1引言

闪烁探测器是一种将高能射线或高能粒子转 换成低能光子的探测装置,被广泛应用于核医学 成像、国土安全、深空深海探索、高能物理等领 域¹¹。铊激活碘化钠(Nal:Tl)晶体以其高光输出、 快衰减时间、良好的机械强度和温度稳定性以及 低成本等优点[2-5],成为目前最广泛使用的闪烁晶 体16-91,并且被公认为是评价其他闪烁晶体闪烁性 能的标准^[10]。有研究表明 Tl、In、Eu 掺杂都能在 Nal晶体中产生新的发光中心,其中Tl掺杂由于 同时具有俘获电子和空穴的能力而成为更高效率 的激活剂[11-12]。与此同时,理论估计[13]表明,这种 闪烁体的光输出和能量分辨率都远未达到极限。 因此,如何进一步提高 Nal 闪烁性能是闪烁材料 研究领域的一个重要科学挑战,集中在晶体生长 过程的优化或向熔体中添加杂质元素。如果激发 剂(Tl)的浓度是最佳的,根据能带理论,我们可以 尝试通过共掺和使用更多激发来实现更高的闪烁 效率。

目前,研究人员已经测试了周期表的部分元 素,以确定能否提高能量传递和闪烁效率^[14-15]。发 现 Mn、Pb、Ag、氧化物、硫族元素和卤族元素对 NaI 晶体的性能影响很小^[15]。除去TI掺杂之外,碱 土金属元素与TI共掺或者多掺对 NaI 晶体的闪烁 性能有很大的提升。如Yang等的研究发现Sr²⁺和 Ca²⁺与TI共掺虽然使光输出降低了15%,但是能 量分辨率提升到5.3%,衰减时间减少到170 ns^[16]。 Khodyuk等发现碱土金属元素 Ba和 Eu 共掺可以 同时提高 NaI:TI 晶体的光输出和能量分辨率^[17]。 Zn 位于元素周期表中第IV 周期、第 IIB族,和 Ca 同 周期,可推测 Zn 共掺对 NaI:TI 晶体性能有积极影 响,但相关工作却鲜有报道。

本文通过坩埚下降法(Bridgman法)制备了

NaI:Tl晶体以及NaI:Zn,Tl晶体,并对晶体样品进 行了X射线粉末衍射(XRD)、电感耦合等离子体 发射光谱(ICP-OES)和紫外可见近红外(UV-VIS-NIR)透射光谱测试;利用多道能谱测试设备 (MCA)对晶体的闪烁性能进行了测试。

2 实 验

2.1 样品制备

采用 Bridgman 法^[18]生长 NaI: TI 晶体以及 NaI: Zn,TI 晶体。激活剂 TI 的掺杂浓度为 0.18%(摩尔 分数,下同),Zn 的掺杂浓度为 0.05%、0.08% 以 及 0.4%。按照设定比例称取掺杂料,用混料机进 行充分混合后,采用自发形核技术进行晶体生长。 NaI: Zn, TI 晶体生长的工艺参数为:温度梯度~ 9.5 °C/cm,生长速率 1.5 mm/h,在该条件下得到 了无明显杂质、条纹、气泡、云层且没有开裂等宏 观缺陷的 NaI 晶体。如图 1 所示,其尺寸为 φ 50 mm×100 mm。



图 1 下降法生长的 NaI:Zn,Tl 晶体 Fig.1 NaI:Zn,Tl crystal grown by Bridgman method

为降低热应力,设置退火速率为6.5℃/h,将 退火后的单晶体在室温下取出。经切割、打磨、抛 光等工序制备成 φ44.5 mm×11 mm(测试透过率) 以及 φ38.2 mm×29 mm 晶体块(测试闪烁性能)。 NaI:Zn,Tl晶体测试样品由于易潮解的特性,封装 工序在含水量<10⁻⁶(1 ppm)的手套箱中进行。将 φ38.2 mm×29 mm 晶体块放在具有 φ40 mm×32 mm 单出光面的不锈钢封装盒中进行封装,出光 面通过硅油与 Hamamatsu R2059 光电倍增管耦合,测试透过率和能量分辨率所制备的器件如图 2所示。



图 2 NaI: Zn, Tl 晶体测试器件。(a)测试透过率器件;
 (b)测试能谱图器件。

Fig.2 Devices of NaI: Zn, Tl crystal for test. (a) Device to test transmission spectra. (b) Device to test energy spectra.

2.2 样品表征

在手套箱中,从Nal:Zn,Tl晶体上取一小块 样品并研磨成粉末,加入一定量的硅粉内标物,放 在样品架中并用无明显衍射峰的有机膜密封后, 置于日本理学SmartLab SE型X射线粉末衍射仪 中对样品进行测试。测试条件为:室温,辐射源 Cu(Kα),管电流40 mA,管电压40 kV,扫描范围为 20°~80°,扫描速度为10(°)/min。

在手套箱中,对NaI:Zn,Tl晶体进行取样、称重, 制成一定浓度的溶液,采用德国斯派克SPECTRO ARCOS型电感耦合等离子发射光谱仪进行了元素含 量的测试。测试条件为:电压3470V,阳极电流 0.608A,等离子体流量0.5L/min,辅助流量为0.5 L/min,雾化器流量为12.5L/min,进样延迟为30s。

利用日本岛津 UV3600 PLUS 型紫外-可见-近

红外分光光度计对封装后的 NaI: Zn,Tl 晶体的透 射光谱进行测试,测试波长范围 250~700 nm。采 用 DHN-B022 多道能谱测试仪测试 NaI: Zn,Tl 晶 体的闪烁性能,在测试中使用活度为 0.8 μCi、能 量为 662 keV 的¹³⁷Cs 放射源。

3 结果与讨论

3.1 X射线粉末衍射分析

X射线粉末衍射是研究晶体物相和结构的一种主要方法,NaI:Zn,Tl晶体的X射线粉末衍射测试结果如图3所示。



Fig.3 XRD of NaI:Zn,Tl crystals

与标准卡片(CSD 78-0604)相比, 衍射峰位置 和相对强度基本一致, 无其他杂相峰出现。说明 Zn和Tl离子掺杂并没有改变晶体结构。测试样 品与标准NaI晶体的匹配率因数^[19]FOM值为0.7, 空间群为*Fm-3m*(225)。采用Rietveld方法对晶体 结构进行了精化修正, 以Pearson III函数为峰形函 数, 修正了包括峰宽函数、峰形参数、歪斜因子、择 优取向、晶粒尺寸和温度因子等参数。精修得到 的加权拟合因子 *R*_{wp}<0.1104, 期望因子 *R*_{exp}< 0.0992, 精修后的NaI: Zn, Tl 晶体的晶胞参数和 体积见表1。

表1 Nal:Zn,Tl晶体的晶格常数和体积

Tab. 1 Lattice constants and volumes of NaI:Zn, Tl crystals						
样品	晶格常数/nm a=b=c	晶格体积/nm ³	$\Delta V/nm^3$	密度/(g•cm ⁻³)		
NaI:Tl	0. 647 0	0. 270 84	0	3. 675 0		
NaI:Zn _{0.05} , Tl _{0.18}	0.6471	0. 271 05	0.00021	3. 672 2		
NaI:Zn _{0.08} , Tl _{0.18}	0. 647 7	0. 271 73	0.00068	3.6630		
NaI:Zn _{0.4} , Tl _{0.18}	0. 648 7	0. 272 97	0.001 24	3. 646 3		

从表1中可以看出,随着Zn掺杂浓度增加, 晶体的晶胞体积增加,有研究结果^[20]提出异价离 子掺杂并未因为杂质离子半径大而导致晶格体积 增加,反而由于电荷之间更强的相互作用,导致晶格体积向相反方向变化。异价离子Zn²⁺在进入晶体后取代一个Na⁺离子,+2价的Zn对周围的电荷

产生更强的相互作用,从而导致晶格常数增加,晶体体积变大。

3.2 电感耦合等离子发射光谱分析

掺杂离子在晶体中的含量直接影响其在晶体中的占位进而影响基质材料的性能。Tl离子作为激活剂掺入NaI晶体中可形成发光中心^[12],因此其含量是决定NaI晶体光输出的一个重要参量,NaI:Zn,Tl晶体中,Zn和Tl离子浓度的测试结果如表2所示。

从表2中可以看出,随着Zn掺杂浓度增加, 生长的NaI:Zn,Tl晶体中的Zn²⁺浓度依次增加,而 相对应的Tl⁺浓度降低。这是由于Zn²⁺离子半径 (72 pm)小于Na⁺半径(102 pm),而Tl⁺离子(159 pm)半径大于Na⁺半径,在共掺杂时Zn²⁺会更容易 占据晶体中的缺陷位置,使掺入的Tl⁺浓度降低。

表 2 Nal: Zn, Tl 晶体中的 Zn 和 Tl 离子浓度

Tab. 2 Element's concentration in NaI:Zn,Tl crystals

	掺杂元素浓度/%		
作印	Zn	Tl	
NaI:Tl _{0.18}	0	0.0480	
$NaI:Zn_{0.05}, Tl_{0.18}$	0.0136	0.0380	
NaI:Zn _{0.08} , Tl _{0.18}	0.0168	0.037 5	
NaI:Zn _{0.4} , Tl _{0.18}	0.0218	0.0298	

3.3 紫外-可见透射光谱分析

晶体透过率是光子入射到晶体时,透过晶体 的辐射能量与入射到晶体上的总辐射能量之比。 紫外-可见透射光谱测试结果如图4所示。



Fig.4 The UV-Vis transmittance spectra of NaI:Zn,Tl crystals

从图4中可以看出,截止吸收边基本一致,说明Zn²⁺掺杂并未影响NaI晶体的带隙结构;随着Zn²⁺掺杂浓度的增加,透过率呈现先增大后减小

的趋势,Zn²⁺掺杂浓度为0.08%时,样品的透过率 最高。这是由于 NaI:TI晶体中存在肖特基缺 陷^[21],低浓度Zn²⁺掺杂会减少肖特基缺陷,抑制由 肖特基缺陷引起的光吸收,提高了透过率。当 Zn²⁺掺杂浓度升高时,新缺陷产生的光损耗超过 肖特基缺陷减少引起的透过率提高效果,晶体透 过率反而又有所降低。

在 350~700 nm 之间,样品的透过率均高于 70%,说明晶体具有良好的透过率,光学均匀性 高。同时晶体在 250~300 nm 波段有一个透过峰, 主要是由于 Tl⁺在 300 nm 附近有一个强吸收带^[15] 形成。

3.4 闪烁性能

能量分辨率是表征闪烁晶体辐射探测器分辨 最小粒子能量之间差距的参数;相对光输出是晶 体将高能粒子转化为可见光的能力大小的指标, 为测试样品与NaI:Tl样品光输出的比值得到的 相对值。通过获取¹³⁷Cs源发出的662 keV 伽马射 线的能谱图,采用高斯函数拟合出662 keV 如应 的高斯峰,通过该高斯峰所在的通道数来表征晶 体光输出大小。在同样的实验条件下获取 NaI: Tl 晶体能谱图中高斯峰对应的通道数,两者之比 为晶体的相对光输出。将上述高斯峰的半高宽 (FWHM)除以其所在的通道数即可获得晶体的能 量分辨率^[22]。NaI:Zn,Tl 晶体的能谱图测试结果如 图5所示。





NaI: Zn, Tl 晶体的能量分辨率及相对光输出 计算结果如表3所示。

从表 3 中可以看出,在¹³⁷Cs放射源激发下,Zn 掺量为 0.05%、0.08%时的 NaI:Zn,Tl 晶体的能量 分辨率均小于 NaI:Tl,光输出相对于 NaI:Tl 晶体 增加了 6%~10%。其中 Zn 的掺杂浓度在 0.4% 时

	表3	Nal:Zn,Tl晶体的闪烁性能
Tab. 3	Scint	illation properties of NaI : Zn , Tl crystals

			-
S	FWHM	Relative	Energy
Sample		light output	resolution/%
NaI: Tl _{0. 18}	42.7	1.00	7.30
NaI:Zn _{0.05} , Tl _{0.18}	43.5	1.10	6.78
NaI:Zn _{0.08} , Tl _{0.18}	42.1	1.06	6.80
NaI:Zn _{0.4} ,Tl _{0.18}	53.2	1.14	8.01

相对光输出最高达到 1.14, 而 Zn 掺杂浓度在 0.05% 时能量分辨率最优。

根据Su的实验结果^[23],NaI:TI晶体中,TI离子的 浓度在0.022%~0.073%之间时具有较稳定的光输 出,在0.01%~0.11%之间能量分辨率不超过8%, 具有较好的能量分辨率。本文中所测试的NaI:Zn, TI晶体中TI离子的浓度均在该范围内。

根据 Adhikari等的研究^[24], T1作为激活剂掺入 NaI 晶体中,既可以俘获空穴形成 T1_{Na},也可以俘 获电子形成 T1_{Na},从而在禁带中形成新的激发态 能级,晶体在被辐照以后电子退激发出光子。当 NaI:T1与 Zn²⁺共掺杂时,T1_{Na}和 Zn_{Na}由于电负性不 同而结合在一起,形成了中性缺陷复合体 T1_{Na}+ Zn^{*}_{Na}(即 T1⁰ + Zn²⁺),即受主-复合体(Donor-complex, DX)中心。DX 中心与 T1⁰都能提高 NaI:T1晶 体的闪烁性能,但DX中心与TI⁰结合导致产生新 激发态的TI⁰数量减少。在掺杂浓度较低时,DX 中心与TI⁰共同作用提升了NaI:TI晶体的闪烁性 能。但随着Zn²⁺掺杂浓度的进一步增加,TI⁺浓度 下降,同时DX中心与TI⁰结合导致TI⁰减少从而又 导致晶体的能量分辨率增加。

4 结 论

本文通过坩埚下降法制备出无明显杂质、开裂、气泡、云层等宏观缺陷的NaI:Zn,Tl晶体,晶体的尺寸为 φ50 mm×100 mm。在¹³⁷Cs放射源激发下,Zn 掺量为0.05%、0.08%时的NaI:Zn,Tl晶体的能量分辨率分别为6.78%、6.80%,光输出相对于NaI:Tl晶体增加了6%~10%。闪烁性能的提升以及低廉的成本将有助于NaI:Zn,Tl晶体在石油测井、安检、工业及医疗CT、环境检测等领域得到更广泛的应用。下一步,可通过晶体生长工艺参数的优化使掺杂离子在NaI晶体中均匀分布,同时进行共掺杂的工作,进一步提升NaI:Tl晶体的闪烁性能。

本文专家审稿意见及作者回复内容的下载地址: http://cjl. lightpublishing. cn/thesisDetails#10.37188/ CJL. 20230171.

参考文献:

- [1]杨洁男,闻学敏,魏钦华,等.红光-近红外发光卤化物闪烁晶体研究现状[J].发光学报,2021,42(11):1661-1672.
 YANG J N, WEN X M, WEI Q H, et al. Current status of red and near-infrared emission halide scintillation crystals
 [J]. Chin. J. Lumin., 2021, 42(11): 1661-1672. (in Chinese)
- [2] DE HAAS J T M, DORENBOS P. Advances in yield calibration of scintillators [J]. IEEE Trans. Nucl. Sci., 2008, 55 (3): 1086-1092.
- [3] GRABMAIER B C. Crystal scintillators [J]. IEEE Trans. Nucl. Sci., 1984, 31(1): 372-376.
- [4] HOLL I, LORENZ E, MAGERAS G. A measurement of the light yield of common inorganic scintillators [J]. IEEE Trans. Nucl. Sci., 1988, 35(1): 105-109.
- [5] SAKAI E. Recent measurements on scintillator-photodetector systems [J]. *IEEE Trans. Nucl. Sci.*, 1987, 34(1): 418-422.
- [6] KIM J, PARK K, HWANG J, et al. Efficient design of a \$\phi 2\$\times 2\$ inch NaI(Tl) scintillation detector coupled with a SiPM in an aquatic environment [J]. Nucl. Eng. Technol., 2019, 51(4): 1091-1097.
- [7] AUSTIN R A, HOOTEN D. Comparison of neutron capture spectra taken by a constellation Xe-110 detector and a 1"×1" NaI(Tl) crystal [J]. J. Radioanal. Nucl. Chem., 2009, 279(2): 395-404.
- [8] KIM K W, ADHIKARI G, ADHIKARI P, et al. Pulse shape discrimination of nuclear recoil and electron recoil events with a NaI(Tl) crystal for dark matter search [J]. IEEE Trans. Nucl. Sci., 2016, 63(2): 534-538.
- [9] KHOSHAKHLAGH M, ISLAMIAN J P, ABEDI S M, et al. Development of scintillators in nuclear medicine [J]. World J. Nucl. Med., 2015, 14(3): 156-159.
- [10] 任国浩,杨帆.卤化物闪烁晶体的研究历史和现状 [J].中国科学:技术科学,2017,47(11):1149-1164. RENGH, YANGF. The research history and present situation of some halide scintillation crystals [J]. Sci. Sinica Technol.,

2017, 47(11): 1149-1164. (in Chinese)

- [11] GRIDIN S, WILLIAMS R T, BELSKY A, et al. Carrier trap parameters in NaI with Tl, In, and Eu dopants [J]. J. Phys. Chem. C, 2019, 123(22): 13519-13530.
- [12] SHIRAN N, GEKTIN A, BOYARINTSEVA Y, et al. Modification of NaI crystal scintillation properties by Eu-doping
 [J]. Opt. Mater., 2010, 32(10): 1345-1348.
- [13] DORENBOS P. Light output and energy resolution of Ce³⁺-doped scintillators [J]. Nucl. Instrum. Methods Phys. Res.
 A, 2002, 486(1-2): 208-213.
- [14] HANSON H G. Quenching of NaI fluorescence by H₂, HCl, CO₂, and H₂O [J]. J. Chem. Phys., 1955, 23(8): 1391-1397.
- [15] SABHARWAL S C, KATHURIA S P, GHOSH B. Effect of impurities on scintillation-optical and thermoluminescent properties of NaI(Tl) [J]. Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. A, 1987, 255(3): 501-506.
- [16] YANG K, MENGE P R. Improving γ-ray energy resolution, non-proportionality, and decay time of NaI: Tl⁺ with Sr²⁺ and Ca²⁺ co-doping [J]. J. Appl. Phys., 2015, 118(21): 213106.
- [17] KHODYUK I V, MESSINA S A, HAYDEN T J, et al. Optimization of scintillation performance via a combinatorial multielement co-doping strategy: application to NaI:Tl [J]. J. Appl. Phys., 2015, 118(8): 084901.
- [18] DER MATEOSIAN E, MCKEOWN M, MUEHLHAUSE C O. Response of sodium iodide crystals to alpha particles and electrons as a function of temperature [J]. Phys. Rev., 1956, 101(3): 967-971.
- [19] STONEHAM A M, ITOH N. Materials modification by electronic excitation [J]. Appl. Surf. Sci., 2000, 168(1-4): 186-193.
- [20] 吴成国, 裴克梅, 何苏红, 等. Mn²⁺/Eu³⁺共掺杂Zn₂GeO₄长余辉基质材料发光机理的研究[J]. 四川大学学报(自然 科学版), 2021, 58(6): 064006.

WU C G, PEI K M, HE S H, *et al.* Luminescence mechanism studies on Mn^{2+}/Eu^{3+} co-doped Zn_2GeO_4 long afterglow system [J]. *J. Sichuan Univ.* (*Nat. Sci. Ed.*), 2021, 58(6): 064006. (in Chinese)

- [21] BLACKIOCKS A N, CHADWICK A V, JACKSON R A, et al. Investigation into thallium sites and defects in doped scintillation crystals [J]. Phys. Status Solidi C, 2007, 4(3): 1008-1011.
- [22] 郑睿. PET用大尺寸硅酸钇镥闪烁晶体可控生长和均一性优化 [D]. 武汉: 华中科技大学, 2021.
 ZHENG R. Controllable Growth and Uniformity Optimization of Large Size LYSO: Ce Scintillation Crystal for PET Application [D]. Wuhan: Huazhong University of Science and Technology, 2021. (in Chinese)
- [23] SU T M R, RILEY S J. Alkali halide photofragment spectra. I. Alkali iodide bond energies and excited state symmetries at 266 nm [J]. J. Chem. Phys., 1979, 71(8): 3194-3202.
- [24] ADHIKARI R, LI Q, WILLIAMS R T, et al. DX-like centers in NaI: Tl upon aliovalent codoping [J]. J. Appl. Phys., 2014, 116(22): 223703.



田东升(1982-),男,内蒙古呼和浩特 人,硕士,实验师,2007年于上海理工 大学获得硕士学位,主要从事凝聚态 物理的研究。

E-mail: tds@ysu. edu. cn



贾永超(1986-),男,河北邢台人,博 士,讲师,2014年于中国科学院长春 应用化学研究所获得博士学位,主要 从事稀土发光材料的设计与第一性原 理的研究。

E-mail: yongchao. jia@ysu. edu. cn



徐悟生(1972-),男,黑龙江哈尔滨人, 博士,高级工程师,2004年于哈尔滨 工业大学获得博士学位,主要从事无 机非金属材料的研究。 E-mail: wusheng. xu@icc-crystal.com



徐朝鹏(1977-),男,黑龙江伊春人,博 士,教授,2006年于哈尔滨工业大学 获得博士学位,主要从事光电信息功 能材料的研究。

E-mail: xuzhaopeng1@163.com